



日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2000年 8月10日

出 願 番 号

Application Number:

特願2000-243184

出 願 人

Applicant(s):

キヤノン株式会社

2001年 8月24日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

及 川 耕 造

出証番号 出証特2001-3075845

【書類名】 特許願

【整理番号】 4266074

【提出日】 平成12年 8月10日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H04N 5/32

【発明の名称】 放射線撮像装置および放射線撮像システム

【請求項の数】 6

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社  
社内

【氏名】 梶原 賢治

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社  
社内

【氏名】 浜本 修

【特許出願人】

【識別番号】 000001007

【氏名又は名称】 キヤノン株式会社

【代表者】 御手洗 富士夫

【代理人】

【識別番号】 100065385

【弁理士】

【氏名又は名称】 山下 穰平

【電話番号】 03-3431-1831

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 010700

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

特 2 0 0 0 - 2 4 3 1 8 4

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9703871

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 放射線撮像装置および放射線撮像システム

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 放射線を光に変換する波長変換手段と、該光を電気信号に変換する光電変換手段と、該波長変換手段と該光電変換手段との間において該波長変換手段からの光を該光電変換手段に導く、放射線遮蔽が可能な導光手段とを備えた放射線撮像装置において、

前記導光手段は複数の導光基体を接着材を介して繋ぐことで構成されるとともに、前記光電変換手段は複数の画素が行列状に配されて構成され、

前記導光基体の繋ぎ方向の前記接着材の幅は、該繋ぎ方向に配列された前記画素の幅よりも小さいことを特徴とする放射線撮像装置。

【請求項 2】 請求項 1 に記載の放射線撮像装置において、前記接着材の幅は、前記画素の開口部の幅よりも小さいことを特徴とする放射線撮像装置。

【請求項 3】 請求項 1 に記載の放射線撮像装置において、前記接着材の幅は、前記光電変換手段内で最小の画素の幅よりも小さいことを特徴とする放射線撮像装置。

【請求項 4】 請求項 1 ～ 3 のいずれかの請求項に記載の放射線撮像装置において、前記導光基体はファイバプレートである放射線撮像装置。

【請求項 5】 請求項 1 ～ 4 のいずれかの請求項に記載の放射線撮像装置において、前記光電変換手段は複数の光電変換基体を繋いで構成され、各光電変換基体は複数の画素が行列状に配されて構成されていることを特徴とする放射線撮像装置。

【請求項 6】 請求項 1 ～ 5 のいずれかの請求項に記載の放射線撮像装置と、  
前記放射線撮像装置からの信号を処理する信号処理手段と、  
前記信号処理手段からの信号を表示するための表示手段と、  
前記放射線を発生させるための放射線源と、を  
具備することを特徴とする放射線撮像システム。

【発明の詳細な説明】

## 【 0 0 0 1 】

## 【 発明の属する技術分野 】

本発明は、放射線撮像装置、それを備えた放射線撮像システム及びそれに備えられたファイバプレート基体に関し、特に、放射線を光に変換する変換手段と、光を電気信号に変換する光電変換素子と、変換手段からの光を光電変換素子へ導くファイバプレートとを備えた放射線撮像装置、それを備えた放射線撮像システム及びそれに備えられたファイバプレート基体に関する。

## 【 0 0 0 2 】

## 【 従来技術 】

放射線撮像装置、特に医療を目的とする X 線撮影装置では X 線動画が可能で画像品位が優れ、かつ、薄型で大面積入力範囲を有する X 線撮像装置が求められている。また医療用のみならず、産業用非破壊検査機などにも薄型で安価な大面積の X 線撮像装置が求められている。

## 【 0 0 0 3 】

このような X 線撮像装置としては、例えば、(1) ファイバプレートのファイバ繊維に傾斜を設け CCD センサの非受光部 ( 周辺回路 ) が干渉しあうことを防ぎ大面積化した X 線検出装置 ( 例えば、米国特許第 5,563,414 号 )、(2) ファイバプレートの厚みに段差をつけて CCD センサの非受光部が干渉しないように大面積化した X 線検出装置 ( 例えば、米国特許第 5,834,782 号 ) などがある。

## 【 0 0 0 4 】

上記 (1) の構成の X 線検出装置の概略的断面図を図 1 2 に示す。図 1 2 には、X 線を可視光に変換するシンチレータなどからなる蛍光体 3 と、蛍光体 3 によって変換された可視光を撮像素子 1 側へ導く光ファイバなどのファイバプレート 2 と、ファイバプレート 2 によって変換された可視光を電気信号に変換する撮像素子 1 とを示している。

## 【 0 0 0 5 】

この X 線撮像装置は、ファイバプレート 2 を撮像素子 1 に対して傾斜を設けており、ファイバプレート 2 間には、各撮像素子 1 からの電気信号を処理する

処理回路等が設けられている。

【0006】

上記(2)の構成のX線検出装置の概略的斜視図を図13に示す。図13において、図12と同様の部分には、同一の符号を付している。

【0007】

図13に示すように、ファイバプレート2の長さを変えて、たとえば3つの撮像素子1を一組として各組毎に段差を設けることによって、各撮像素子1に処理回路等を備えられるようにしている。

【0008】

【発明が解決しようとする課題】

しかし、上記(1)の構成は、まず、斜めにファイバプレートを切断するため、ファイバプレートの加工が困難なこと、加えてロット当りの取り個数が少なくなるので価格が高くなるといった問題がある。また、傾斜を設けると、ファイバプレートの各ファイバーで光の伝送効率が悪くなりセンサーの感度が低下する。さらに、図示したものは2×2ブロックのファイバプレートを貼り合わせたもので、現有するファイバプレートを使用すると100×100mm程度の大きさが限界である。しかるにファイバーの傾斜を変えて3×3等にすると、各撮像素子内の画素のうち、中央に配置しているファイバプレートよりも、周辺に配置しているファイバプレートの方が光の透過率が劣り、各撮像素子から出力される信号にムラが生じる。また、上記(2)の構成は、X線撮像装置が大型化するという問題がある。また、各段差部分と撮像素子との位置合わせ精度が厳しいため、製造工数が多くなり、且つ高精度な位置あわせ装置が必要になる。これらを鑑みると上記(2)の構成は現実的ではない。

【0009】

上記従来のX線撮像装置では、X線撮像装置の大型化、低コスト化、製造工程での作業性等の要請に対して必ずしも十分なものではなかった。

【0010】

本発明の目的は、X線撮像装置の大型化、低コスト化に適し、製造工程での作業性により優れた放射線撮像装置及び放射線撮像システムを提供することにある

## 【 0 0 1 1 】

## 【課題を解決するための手段】

本発明の放射線撮像装置は、放射線を光に変換する波長変換手段と、該光を電気信号に変換する光電変換手段と、該波長変換手段と該光電変換手段との間にあって該波長変換手段からの光を該光電変換手段に導く、放射線遮蔽が可能な導光手段とを備えた放射線撮像装置において、

前記導光手段は複数の導光基体を接着材を介して繋ぐことで構成されるとともに、前記光電変換手段は複数の画素が行列状に配されて構成され、

前記導光基体の繋ぎ方向の前記接着材の幅は、該繋ぎ方向に配列された前記画素の幅よりも小さいことを特徴とするものである。

## 【 0 0 1 2 】

本発明の放射線撮像システムは、上記本発明の放射線撮像装置と、前記放射線撮像装置からの信号を処理する信号処理手段と、前記信号処理手段からの信号を表示するための表示手段と、前記放射線を発生させるための放射線源と、を具備することを特徴とするものである。

## 【 0 0 1 3 】

## 【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。なお、本発明の放射線撮像装置は以下に説明する X 線撮像装置に好適に用いることができるが、特にその用途が X 線撮像装置に限定されず、 $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$  線等の X 線以外の放射線を検出する放射線撮像装置に用いることができる。

## 【 0 0 1 4 】

## (実施形態 1)

図 1 は本発明の X 線撮像装置の一実施形態の平面図、図 2 はその断面図である。図 1 及び図 2 には、X 線を可視光等の撮像素子で検知可能な波長の光に変換する波長変換手段としての蛍光体 3 と、蛍光体 3 によって変換された光を撮像素子側へ導く複数の（導光基体となる）ファイバプレート 2 d を繋いだ（導光手段

となる)ファイバプレート基体2と、ファイバプレート2dを相互に接着する接着材7と、ファイバプレート基体2と複数の画素を備えた撮像素子(光電変換基体)1とを接着する弾性に優れた透明接着材6と、光を電気信号に変換する撮像素子1と、撮像素子1からの電気信号を外部に出力するフレキシブル基板4と、フレキシブル基板4と撮像素子1とを電氣的に接続する bumps 5と、蛍光体3を保護するアルミ保護シート8と、撮像素子1を搭載するベース基板10と、ベース基板10を保持するためのベース筐体11と、ベース筐体11に備えられた筐体カバー9と、撮像素子1とファイバプレート2dとの間に設けられた一定間隔を保持するためのスペーサ13と、透明接着材6をファイバプレート2dと撮像素子1との間に介在させるための目地うめ接着材14とを示している。X線撮像装置は、撮像素子1とファイバプレート基体2とを、透明接着材6によって貼り合わせることで、形成している。撮像素子1は複数の画素が2次元状に配置されてなり、CCDやCMOSセンサ等から構成される。ファイバプレート2dに鉛等の放射線遮蔽が可能な材料を含ませれば、蛍光体3から漏れたX線を遮蔽する機能を有する。撮像素子1は行列状にベース基板10上に配置され、光電変換手段を構成する。

## 【0015】

上記のX線撮像装置は、複数個のファイバプレート2dを透明接着材6による接着により貼り付け大判化し、さらに、大判化したファイバプレートに複数の撮像素子を搭載するベース基板を貼り付けたものである。このように、接着により大判化したファイバプレート、額縁を持たない撮像素子と蛍光体とをもちいることで、

- 1) 大面積検出装置を製作することができる。
- 2) 安価の大判ファイバプレートを製作できる。
- 3) ファイバ繊維を曲げたり傾けたりしないので光の利用効率が高い。
- 4) 最小限のファイバ厚みで構成できる。
- 5) ファイバ形状にセンサを合せこむ必要がない。
- 6) ファイバプレートの製造が容易である。
- 7) 蛍光体に成長ムラがないことから画像にムラのない良好な画質がえられる。



## 【 0 0 1 6 】

以上のような作用効果を生み X 線動画が可能で画像品位に優れ、かつ、薄型で信頼性の高い大面積入力範囲を有する X 線撮像装置を提供することができる。しかも安価となる。

## 【 0 0 1 7 】

ここで、ファイバプレートの繋ぎ目であるファイバ接着部が撮像素子（光電変換基体）の周辺画素上に重なるように配置された場合には、ファイバプレート 2 d を貼り合わせるファイバ接着部（繋ぎ目） 7 a はファイバプレート 2 d と光透過率が異なり、このファイバ接着部 7 a 下に撮像素子 1 の画素列が配置され、ファイバ接着部の幅が大きいと複数ラインにわたるライン欠陥となる。また、蛍光体から光に変換されないで透過された漏れ X 線が貼り合わせ接着部を通して撮像素子に入射するとライン状にショットノイズが生じ画像品位を低下させることになり、さらに素子の劣化を引き起こし信頼性の問題が残る。なお周辺画素は後述するように、通常画素の大きさよりも小さくなっている。

## 【 0 0 1 8 】

そこで、本実施形態では図 3 に示すように、ファイバプレート 2 d の接着材 7 の幅 d が撮像素子 1 の画素（通常画素）の幅 P よりも小さくなるようにして（ $d < P$ ）、ファイバ接着部 7 a 下に撮像素子 1 の画素列が配置されても 1 ラインのライン欠陥に抑えられるようにした。接着材 7 に鉛等の放射線遮蔽が可能な材料を含ませれば、蛍光体 3 から漏れた X 線を遮蔽することが可能となる。なお、より好ましくは接着材 7 の幅 d を画素の開口部の幅 a よりも小さくする（ $d < a$ ）ことが望ましい。さらに、通常画素の幅に比べて小さい周辺画素の幅よりもファイバプレートの接着材 7 の幅 d を小さくすることが望ましい（すなわち、ファイバプレート 2 d の接着材 7 の幅 d を撮像素子 1 内で最小の画素の幅よりも小さくすることが望ましい。）。なお、接着材 7 はファイバプレートとの熱膨張係数等の特性が等しい又は近い材質のものが好ましい。

## 【 0 0 1 9 】

以下、図 1 と図 2 に示した X 線撮像装置について更に説明する。

## 【 0 0 2 0 】

図4は、撮像素子1の概略的な構成を示す平面図である。図4には、2次元配列した、それぞれ光電変換素子を含む通常画素101と、駆動回路103の外側に設けられた複数の周辺画素104と、各通常画素101及び各周辺画素104を順次駆動する駆動回路103と、撮像素子1の入出力端子102とを示している。

## 【0021】

通常画素101は、ほぼ撮像素子1の全面に配しており、通常画素101のピッチは、後述するように、 $160\mu\text{m}$ としている。通常画素101間には駆動回路103を分割して分散配置している。なお、周辺画素104は、通常画素101に比べて面積が小さいため、画素信号を補正処理することによって、面積の相違がなくなるようにしている。

## 【0022】

図5(a)は、バンプ5及びフレキシブル基板4付近の概略的断面図、図5(b)は、図5(a)の平面図である。図5には、図1、図2に示した部材の他に、バンプ5に接続されるフレキシブル基板4のインナーリード401と、撮像素子1の端部とインナーリード401とのショート防止及び撮像素子1の端部欠損を防止するポリイミド樹脂層などの有機絶縁層105とを示している。

## 【0023】

図6は、図5に示したバンプ5とフレキシブル基板4との電氣的接続の様子を示す図である。はじめに、有機絶縁層105としてたとえばポリイミド樹脂層を $25\mu\text{m}$ の厚さとなるように形成する。次に、バンプ5とフレキシブル基板4との電氣的接続を行うために、まず、撮像素子1の入出力端子102に、スタッドバンプ方式やメッキなどによりバンプ5を形成する。

## 【0024】

そして、バンプ5とインナーリード401とを、たとえば超音波により金属間接合する。ちなみに、インナーリード401は、銅箔などをエッチングすることによって形成し、ニッケル及び金を用いてメッキを施して、 $18\mu\text{m}$ 程度の厚さとし、またフレキシブル基板の総厚は、 $50\mu\text{m}$ 程度としている。

## 【0025】

次に、撮像素子 1 を保持台 1 7, 1 8 によって保持した状態で、治具 1 9 を保持台 1 7, 1 8 の方向に移動させる。こうして、撮像素子 1 の端部でインナーリード 4 0 1 を図面下側に向けて  $90^\circ$  程度曲げる。

## 【 0 0 2 6 】

図 7 ( a ) は、撮像素子 1 のフレキシブル基板 4 付近の拡大図である。図 7 ( b ) は、図 7 ( a ) の平面図である。図 7 に示すように、図中、X 方向の長さは周辺画素 1 0 4 の幅 ( S 1 ) が通常画素 1 0 1 の幅 ( S 2 ) より小さくなっており (  $S 1 < S 2$  )、各周辺画素 1 0 4 間のピッチ ( P 2 ) 及び各通常画素 1 0 1 と各周辺画素 1 0 4 との間のピッチ ( P 1 ) は一定となるように配置されている (  $P 1 = P 2 = P$  )。さらに、各通常画素 1 0 1 間のピッチも同ピッチ ( P ) となるように配置されている。このことから、画素ピッチはすべて等ピッチとなり、画像品位は劣らない。

## 【 0 0 2 7 】

図 8 は、撮像素子 1 とベース基板 1 0 との接着工程を示す図である。まず、フレキシブル基板 4 を備えた複数の撮像素子 1 を、X, Y, Z 方向及び  $\theta$  (回転) 方向に可動するアライメントヘッド及びアライメントカメラを用いて位置合わせしながらステージ上に載置する。このとき、各撮像素子 1 は、ステージに形成されている孔からバキューム装置などで吸引されることによってステージ上に固定される (図 8 ( a ) )。

## 【 0 0 2 8 】

この状態で、各撮像素子 1 が所要の動作を行うかどうかの検査を行う。この検査では、検査治具を用いて、たとえば静電気などによって各撮像素子 1 が破壊されているかどうかなどを調べる (図 8 ( b ) )。そして、検査の結果、撮像素子 1 に欠陥が発見されれば、その撮像素子の下方のバキューム装置をオフして、アライメントヘッドを用いて交換する (図 8 ( c ) )。

## 【 0 0 2 9 】

つづいて、撮像素子 1 上に、紫外線硬化型又はシリコン樹脂などの接着材を塗布する (図 8 ( d ) )。そして、ベース基板 1 0 に設けられた長孔にフレキシブル基板 4 を挿入して、それから撮像素子 1 とベース基板 1 0 とを密着させ、紫

外線を照射したり加圧することによって接着する（図 8（e））。なお、ここでは、ベース基板 10 には、撮像素子 1 との間における熱膨張率などを考慮して、ガラス又はパーマアロイ（鉄+ニッケル）合金を用いている。

## 【 0 0 3 0 】

そして、撮像素子 1 とベース基板 10 とを接着した後に、バキューム装置をオフにして、ステージなどの治具から撮像素子 1 及びベース基板 10 を取り外す（図 8（f））。

## 【 0 0 3 1 】

図 9 は、撮像素子 1 及びベース基板 10 とファイバースプレート基体 2 とを貼り合わせる工程の説明図である。なお、図 9（a）及び図 9（c）は、断面図、図 9（b）及び図 9（d）は平面図としている。図 8 を用いて説明したように、ベース基板 10 と接着した各撮像素子 1 上に、各撮像素子 1 とファイバースプレート基体 2 との間隔を保持できるように、スペーサ 13 を配置する（図 9（a））。スペーサは球でも円柱形状でも良い。つぎに、シール材及び目地うめ接着材を、撮像素子 1 上に塗布する（図 9（b））。目地うめ接着材は撮像素子 1 間の隙間を埋めるために充填されるものである。シール材は、図 9（b）に示すように一部が開口されており、後述するように、ここから真空注入の方式を用いて透明接着材 6 を充填する。注入する際、真空リークの原因とならぬように目地うめ接着材を撮像素子 1 間の隙間に充填している。

## 【 0 0 3 2 】

それから、スペーサ 13 上に、ファイバースプレート基体 2 を貼り合わせる（図 9（c））。

## 【 0 0 3 3 】

そして、真空チャンバ内で、ファイバースプレート基体 2 と各撮像素子 1 との隙間を真空状態にしたところで、透明接着材 6 を溜めたボートに開口部分をつけ真空状態を大気圧に戻すことで、透明接着材 6 が隙間に充填される。その後、開口部分を封止する（図 9（d））。それから、たとえばシート上の蛍光体 3 をファイバースプレート基体 2 上に貼りつけることによって、X線撮像装置が形成される。

## 【 0 0 3 4 】

なお、蛍光体 3 はファイバプレート 2 上に蒸着する、もしくは粉末状の蛍光体を結合材に混合させて塗布することによって設けることもできるが、この場合、図 9 (c) を用いて説明した工程の前に、ファイバプレート基体 2 上に蛍光体 3 を設けておく。

## 【 0 0 3 5 】

つぎに、図 1 及び図 2 を用いて X 線撮像装置の動作について説明する。蛍光体 3 側に図示しない X 線源を設置し、さらに、X 線源と X 線撮像装置との間に被写体を位置させた状態で、X 線源から X 線を照射すると、その X 線は被写体に曝射される。すると、X 線は被写体を透過するとき強度差を有するレントゲン情報を含んで X 線撮像装置側に送られる。

## 【 0 0 3 6 】

X 線撮像装置側では、蛍光体 3 において、X 線の強度に応じた可視光等の光に変換される。変換されることで得られた光は、ファイバプレート基体 2 を通じて撮像素子 1 側へ伝送される。このとき、ファイバプレート基体 2 と撮像素子 1 とが透明接着材 6 によって接着されているため、光は透明接着材 6 を通過するとき減衰することなく撮像素子 1 に入射される。

## 【 0 0 3 7 】

また、光は、接着材 7 にも入射される。接着材 7 に入射した光は、ここでわずかながら吸収又は反射等されるが、その多くは、撮像素子 1 へ到達する。しかし、上述したように、本実施形態ではファイバプレート 2 d の繋ぎ目の接着材 7 の幅が撮像素子 1 の画素（通常画素）の幅よりも小さくなるようにしている。そのためファイバ接着部 7 下に撮像素子 1 の画素列が配置されても 1 ラインのライン欠陥に抑えられる構成となっている。

## 【 0 0 3 8 】

撮像素子 1 では、入射された光を、光の強度に応じた電気信号に変換する。この電気信号は、図示しない読み出し回路の指示に応じて、バンプ 5 を介してフレキシブル基板 4 に読み出される。フレキシブル基板 4 に読み出された電気信号は、図示しない外部回路基板に送られ、A/D 変換された後に画像処理がされる。

## 【 0 0 3 9 】

## (実施形態 2)

図 1 0 は、実施形態 1 で説明した X 線撮像装置を備えた非破壊検査システムの構成を示す概念図である。図 1 0 には、実施形態 1 で説明した X 線撮像装置 1 0 0 0 と、たとえば電気機器に組み込まれる非破壊検査対象物である被写体 2 0 0 0 と、被写体 2 0 0 0 に X 線を照射するマイクロフォーカス X 線発生器 3 0 0 0 と、X 線撮像装置 1 0 0 0 から出力される信号を処理する画像処理装置 6 0 0 0 と、画像処理装置 6 0 0 0 によって処理された画像を表示するモニタ 4 0 0 0 と、画像処理装置 6 0 0 0 及びモニタ 4 0 0 0 を操作するコントローラ 5 0 0 0 とを示している。

## 【 0 0 4 0 】

図 1 0 に示す非破壊検査システムは、マイクロフォーカス X 線発生器 3 0 0 0 によって発生された X 線を、非破壊検査を行いたい被写体 2 0 0 0 に照射すると、被写体 2 0 0 0 の内部における破壊の有無の情報が、X 線撮像装置 1 0 0 0 を通じて画像処理装置 6 0 0 0 に出力される。画像処理装置 6 0 0 0 では、出力された信号を、前述している各撮像素子 1 の周辺画素間の画像信号を処理したり、ダーク補正などを施して、モニタ 4 0 0 0 に画像として表示する。

## 【 0 0 4 1 】

モニタ 4 0 0 0 に表示されている画像は、コントローラ 5 0 0 0 によって指示を入力することで、たとえば拡大又は縮小したり、濃淡の制御等を行うことができる。こうして、モニタ 4 0 0 0 に表示された画像を通じて、被写体 2 0 0 0 の内部における破壊の有無を検査する。そして、被写体 2 0 0 0 に破壊が発見されなければ、それを良品とみなして電気機器に組み込む。一方、被写体 2 0 0 0 に破壊が発見されれば、それを不良品とみなして製造工程から除外する。

## 【 0 0 4 2 】

## (実施形態 3)

図 1 1 は、実施形態 1 で説明した X 線撮像装置を備えた X 線診断システムの構成を示す概念図である。図 1 1 には、X 線撮像装置 1 0 0 0 を備えたベッドと、被写体 2 0 0 0 に X 線を照射するための X 線発生装置 7 0 0 0 と、X 線撮像装置

1 0 0 0 から出力される画像信号の処理及び X 線発生装置 7 0 0 0 からの X 線の照射時期等を制御するイメージプロセッサ 8 0 0 0 と、イメージプロセッサ 8 0 0 0 によって処理された画像信号を表示するモニタ 4 0 0 0 とを示している。なお、図 1 1 において、図 1 0 で示した部分と同様の部分には、同一の符号を付している。

## 【 0 0 4 3 】

図 1 1 に示す X 線診断システムは、X 線発生装置 7 0 0 0 は、イメージプロセッサ 8 0 0 0 からの指示に基づいて X 線を発生させ、この X 線をベッド上の被写体 2 0 0 0 に照射すると、被写体 2 0 0 0 のレントゲン情報が X 線撮像装置 1 0 0 0 を通じてイメージプロセッサ 8 0 0 0 に出力される。イメージプロセッサ 8 0 0 0 では、出力された信号を、前述している各撮像素子 1 の周辺画素間の画像信号を処理したり、ダーク補正などを施して、図示しないメモリに格納したり、モニタ 4 0 0 0 に画像として表示する。

## 【 0 0 4 4 】

モニタ 4 0 0 0 に表示されている画像は、イメージプロセッサ 8 0 0 0 によって指示を入力することで、たとえば拡大又は縮小したり、濃淡の制御等を行うことができる。こうして、モニタ 4 0 0 0 に表示された画像を通じて、医師が被写体 2 0 0 0 を診察する。

## 【 0 0 4 5 】

なお、以上説明した本発明の各実施形態では、X 線を用いた場合を例に説明したが、 $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$  線等の放射線を用いることができる。また、光は画素により検出可能な波長領域の電磁波であり、可視光を含む。

## 【 0 0 4 6 】

## 【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、複数ラインにわたるライン欠陥を防止でき、より画像品位を向上させ、さらに素子の信頼性を向上させることができる。

## 【図面の簡単な説明】

## 【図 1】

本発明による X 線撮像装置の一実施形態の平面図である。

【図 2】

図 1 の X 線撮像装置の断面図である。

【図 3】

本発明の X 線撮像装置の概略的断面図である。

【図 4】

撮像素子の概略的な構成を示す平面図である。

【図 5】

バンプ及びフレキシブル基板付近の概略的断面図及びその平面図である。

【図 6】

バンプとフレキシブル基板との電気的接続の様子を示す図である。

【図 7】

撮像素子のフレキシブル基板付近の拡大図及び平面図である。

【図 8】

(a) ~ (f) は、撮像素子とベース基板との接着工程を示す図である。

【図 9】

(a) ~ (d) は、撮像素子及びベース基板とファイバプレート基体とを貼り合わせる工程の説明図である。

【図 10】

本発明による X 線撮像装置を備えた非破壊検査システムの構成を示す概念図である。

【図 11】

本発明による X 線撮像装置を備えた X 線診断システムの構成を示す概念図である。

【図 12】

従来の X 線検出装置の第 1 例の概略的断面図である。

【図 13】

従来の X 線検出装置の第 2 例の概略的断面図である。

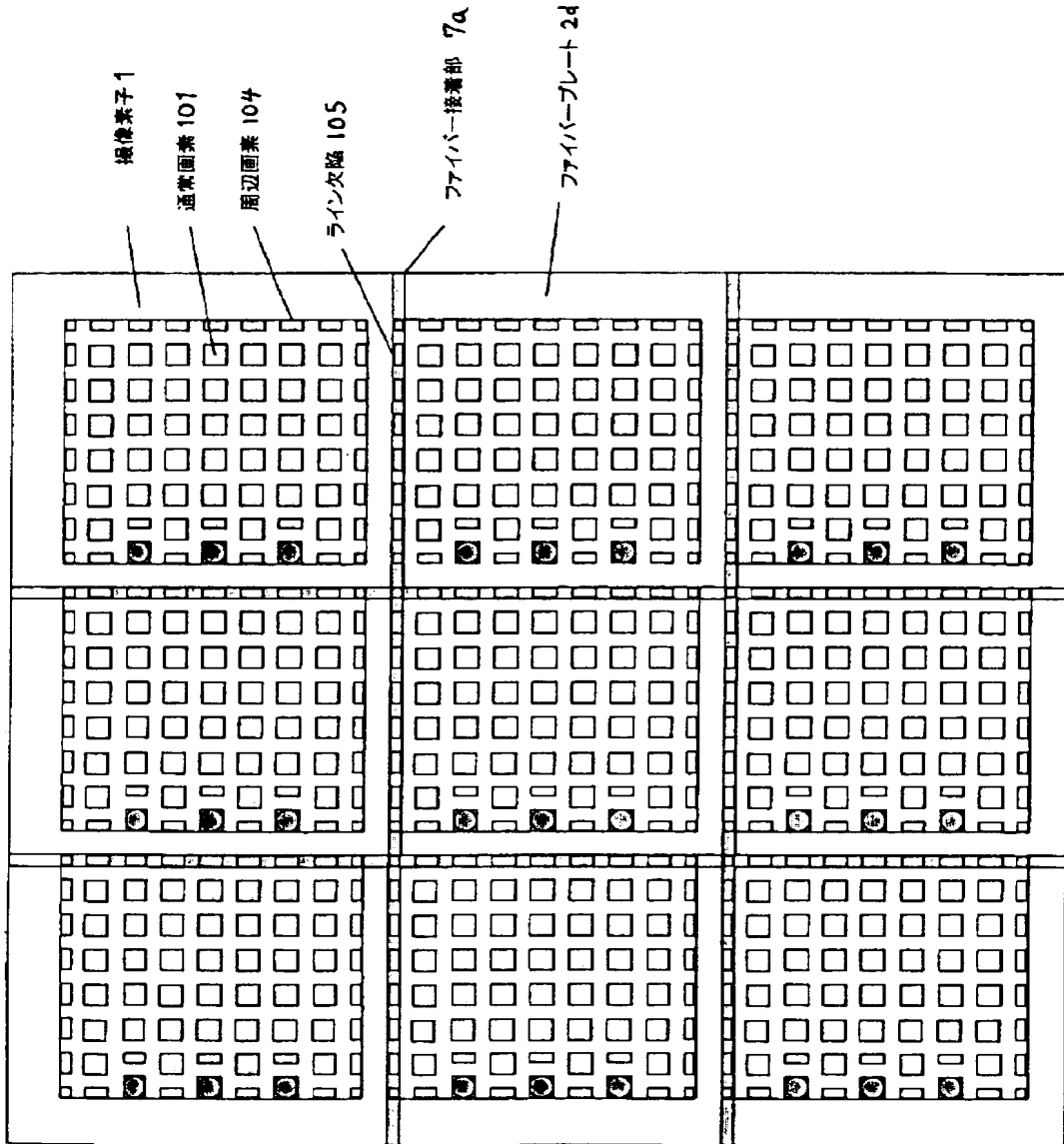
【符号の説明】



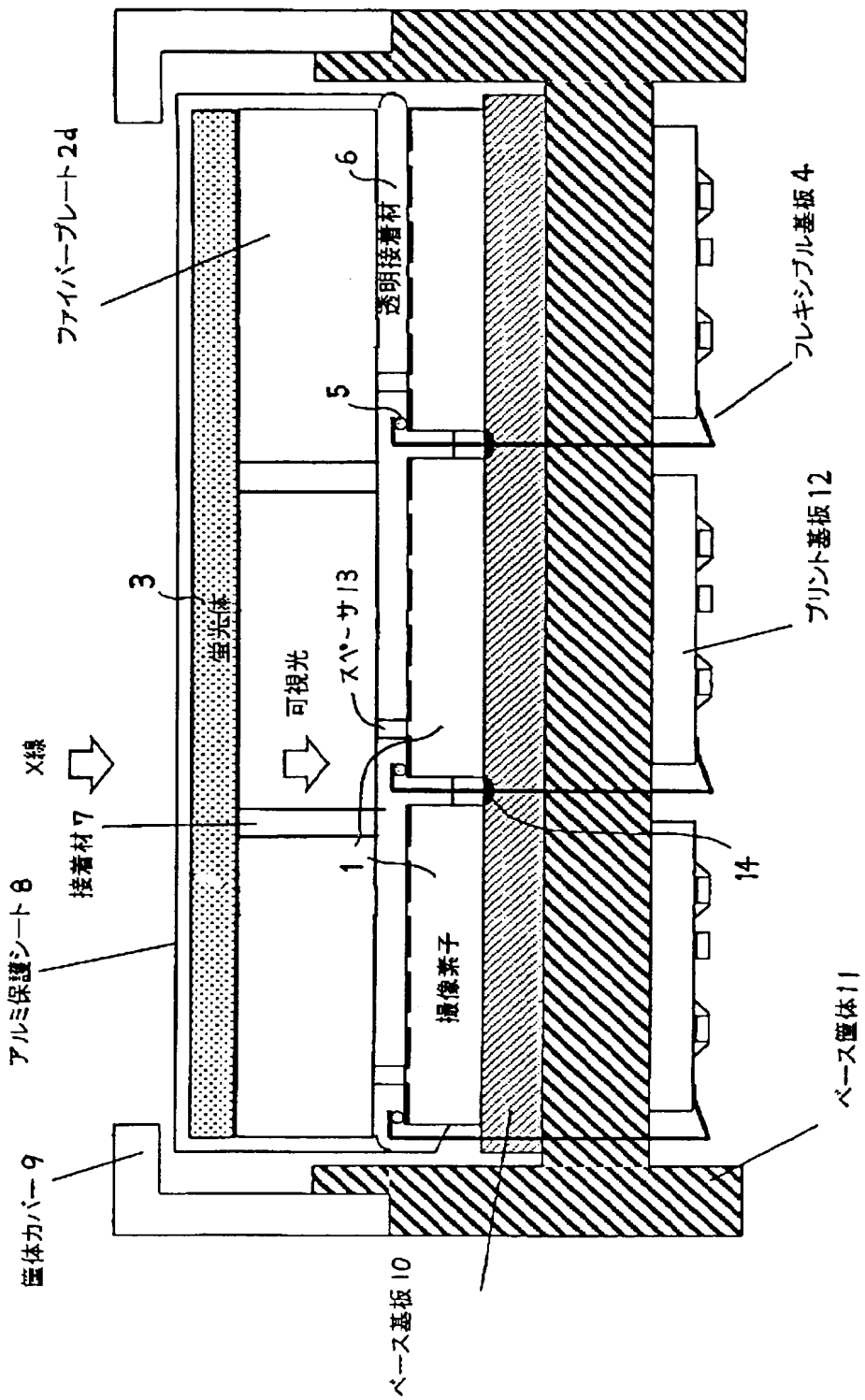
- 1 撮像素子（光電変換基体）
- 2 ファイバプレート基体（導光手段）
- 2 d ファイバプレート（導光基体）
- 3 蛍光体（波長変換手段）
- 4 フレキシブル基板
- 5 バンプ
- 6 透明接着材
- 7 接着材
- 7 a ファイバ接着部
- 8 アルミ保護シート
- 9 筐体カバー
- 1 0 ベース基板
- 1 1 ベース筐体
- 1 3 スペーサ
- 1 4 目地うめ接着材

【書類名】 図面

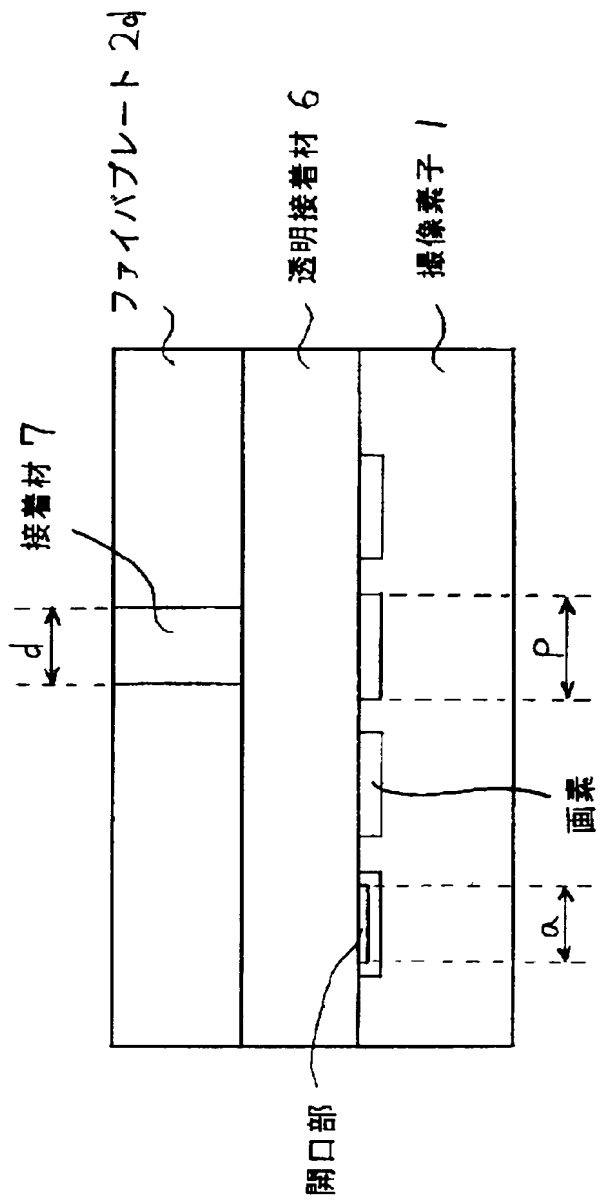
【図1】



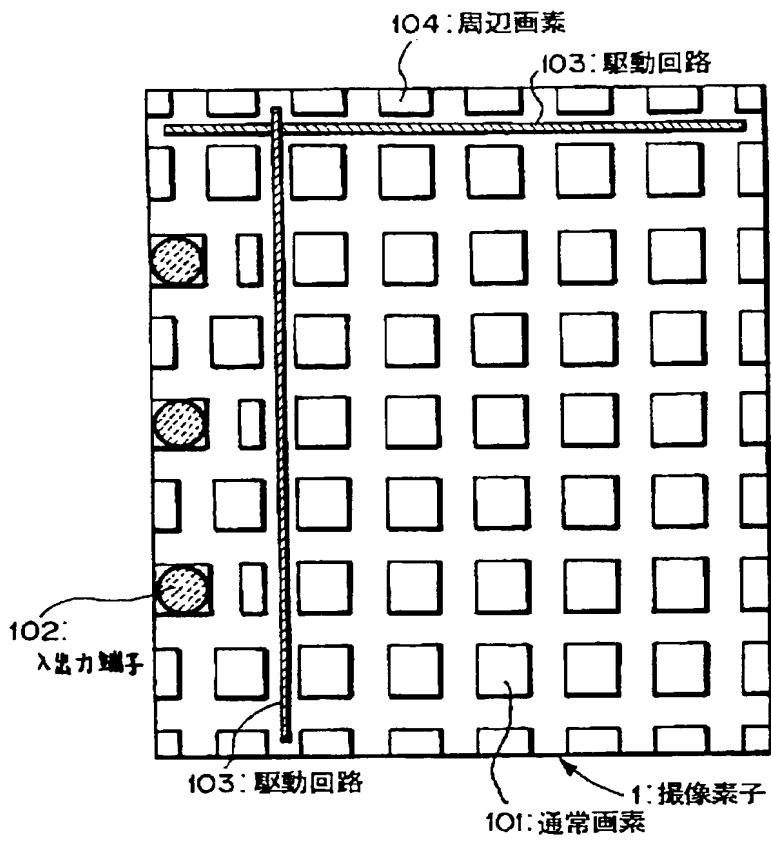
【図2】



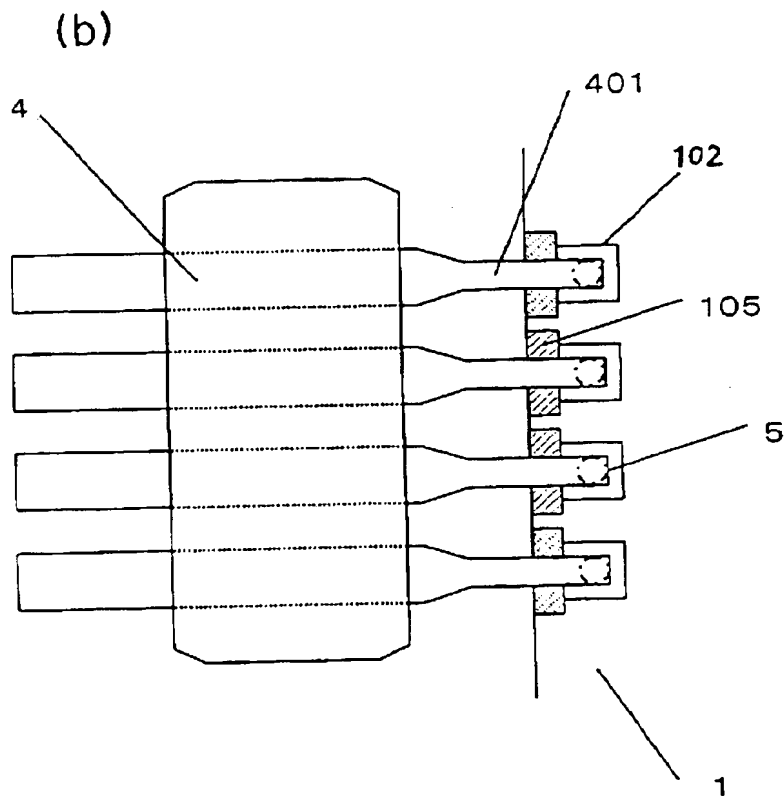
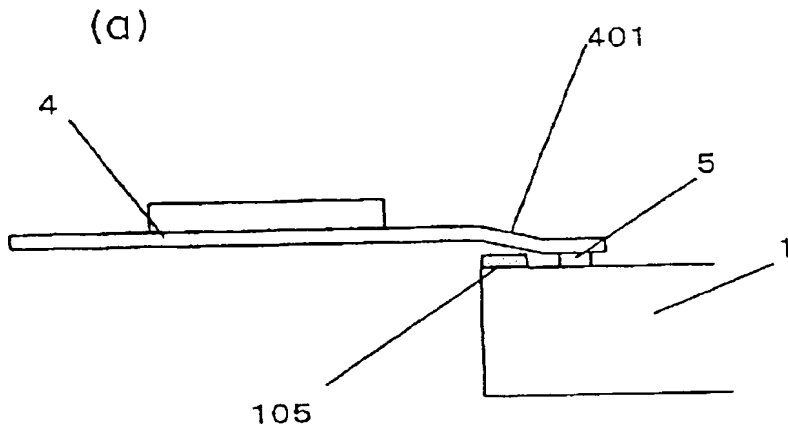
【図3】



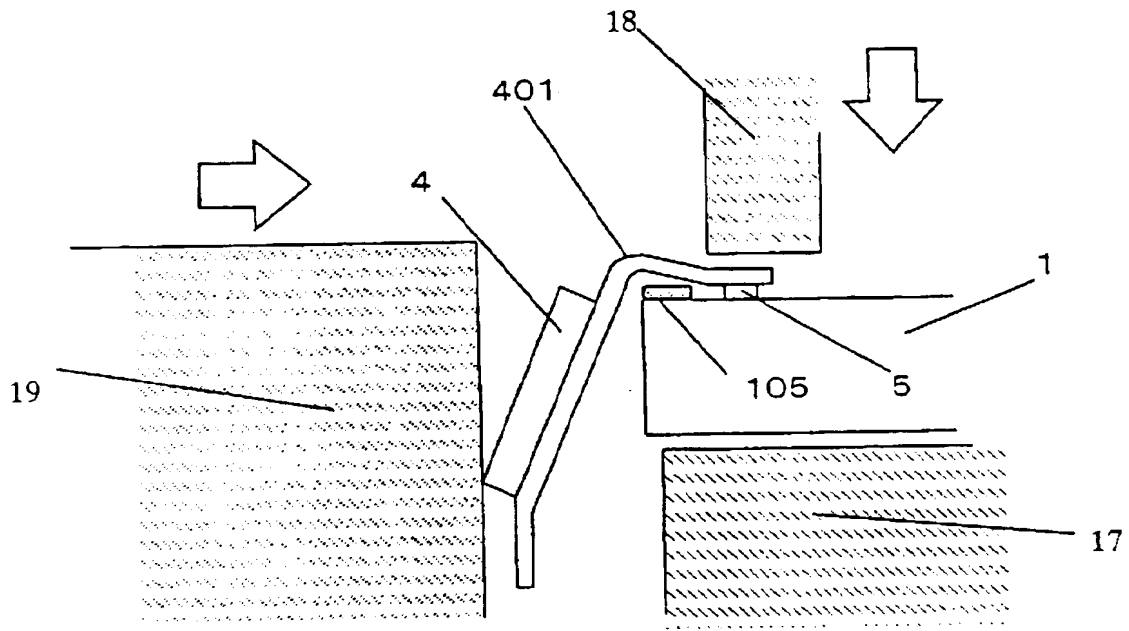
【 図 4 】



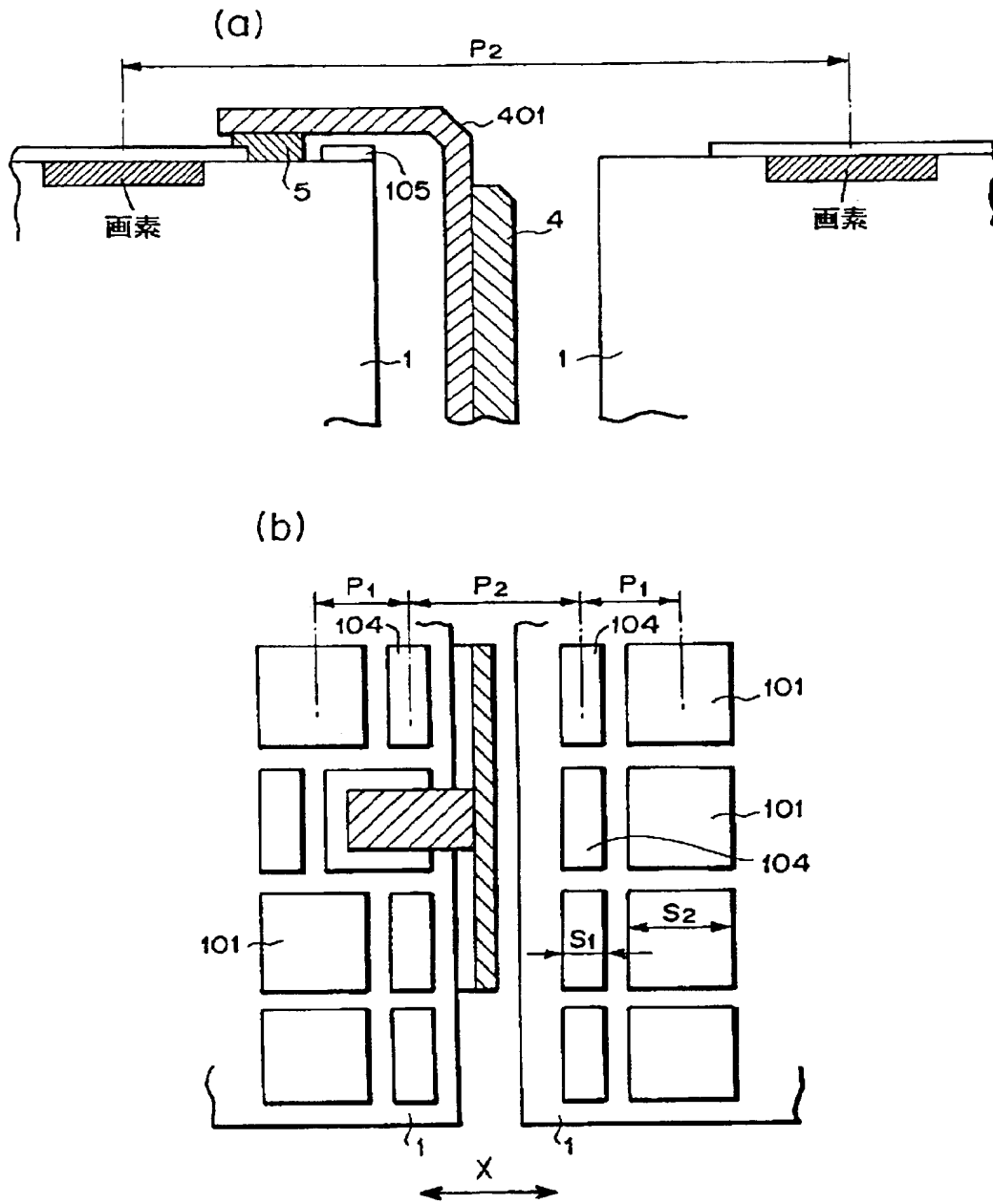
【図 5】



【図 6】

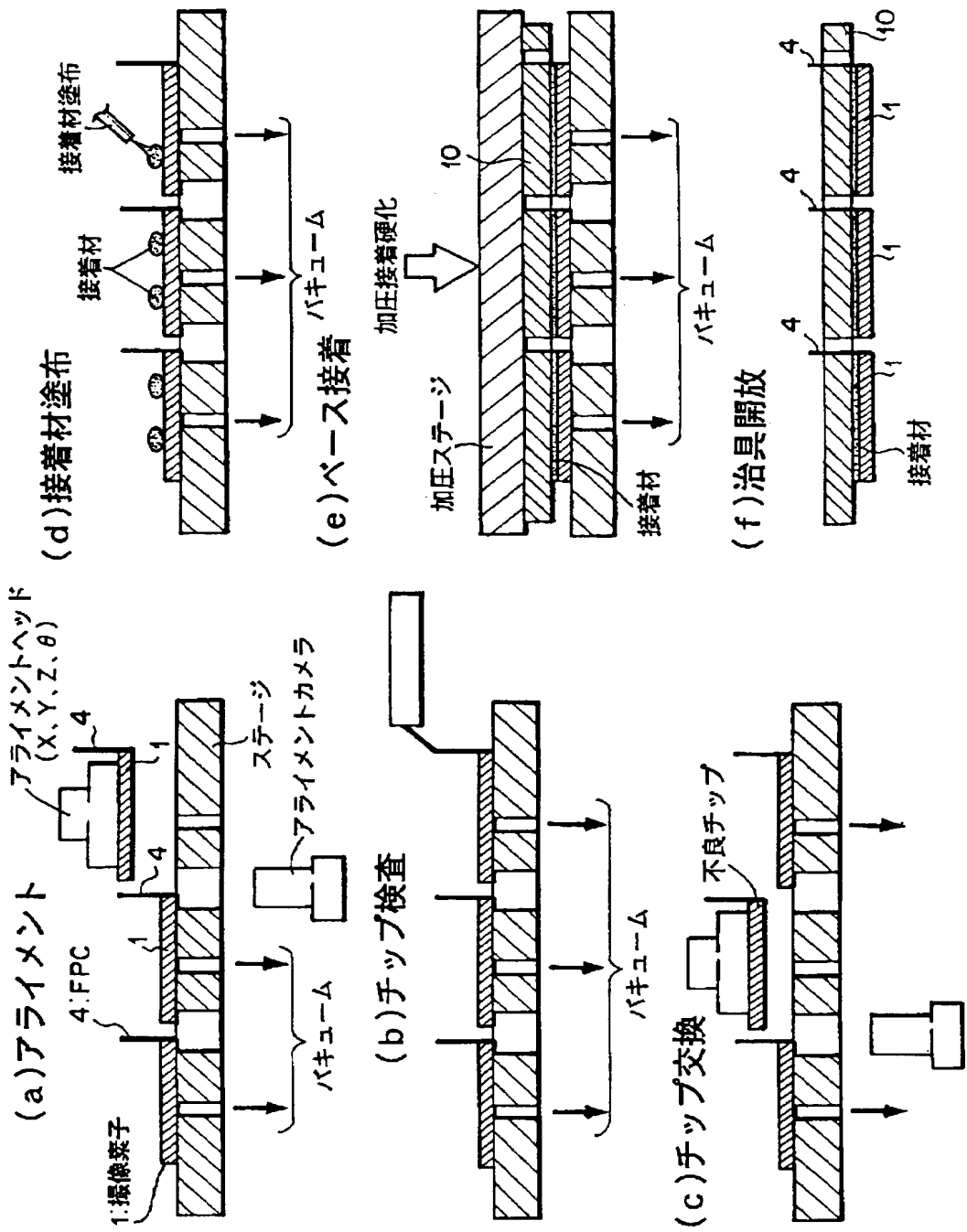


【图 7】



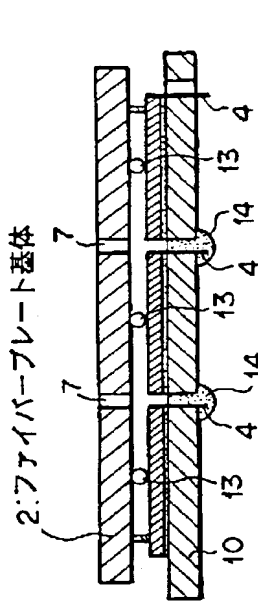


【図8】

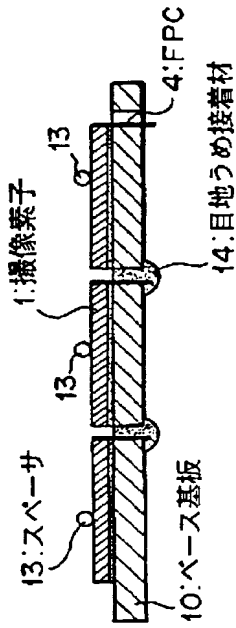


【図 9】

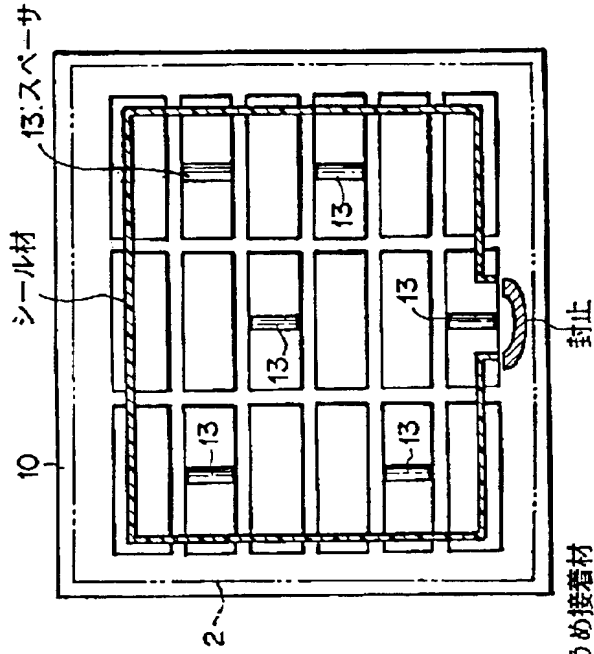
(c) FOP貼り合わせ



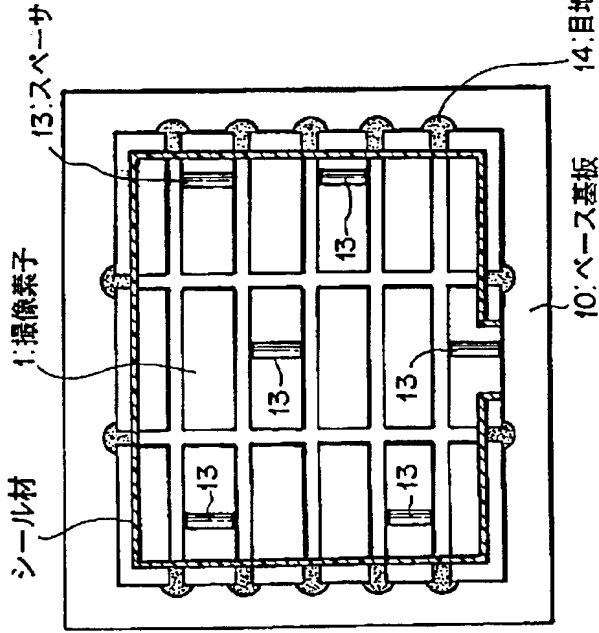
(a) 樹脂スベーサ散布



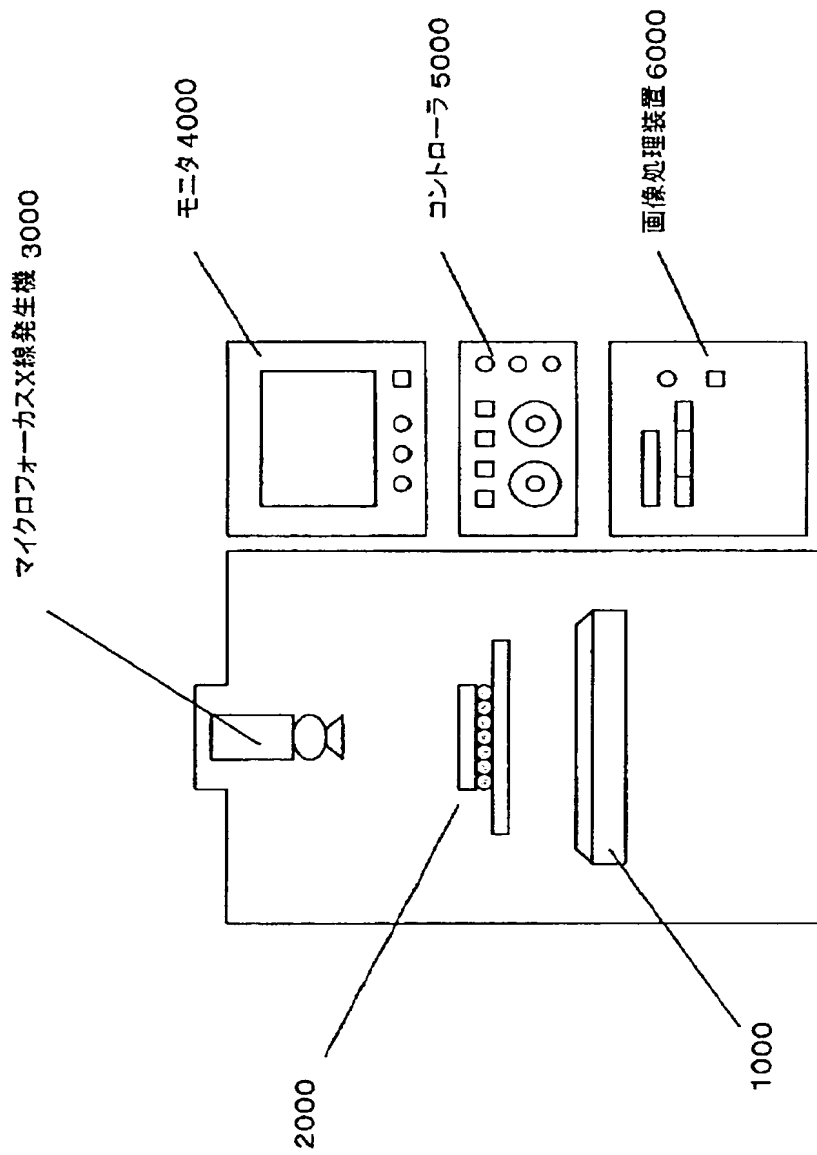
(d) 真空注入と封止



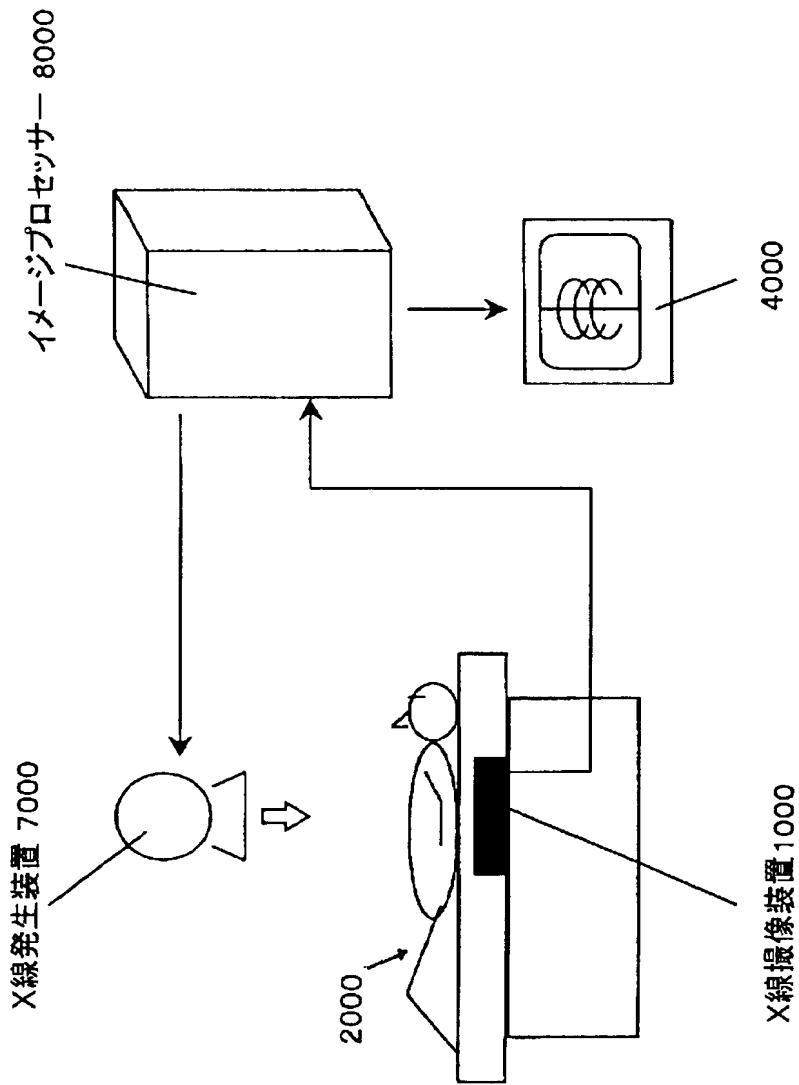
(b) シール材塗布



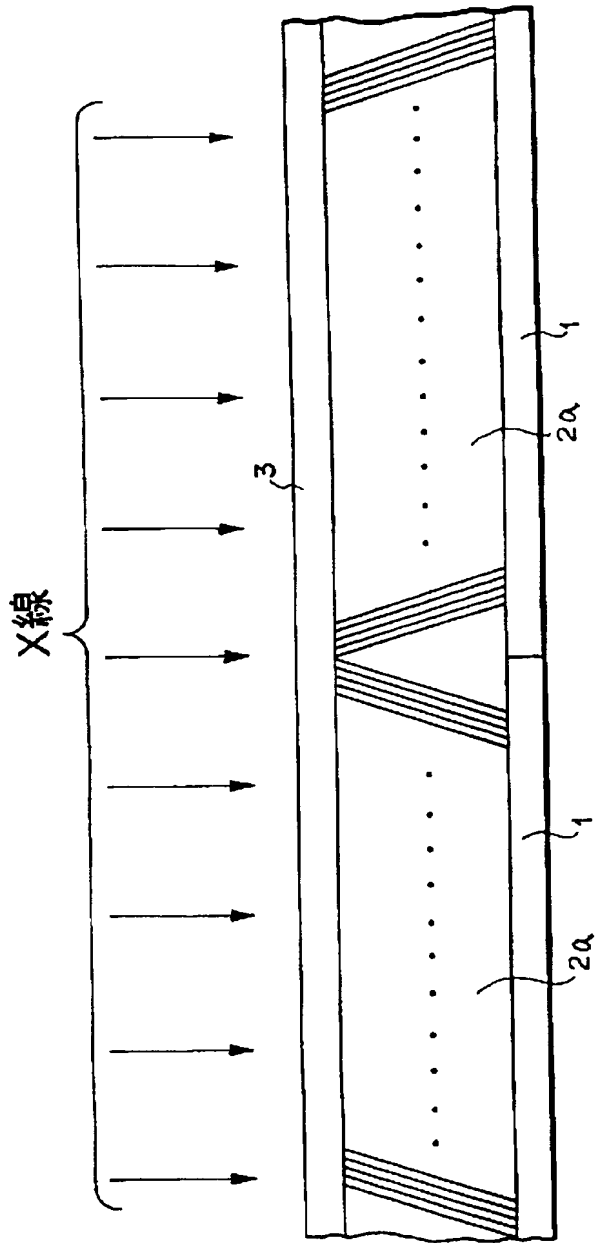
【図10】



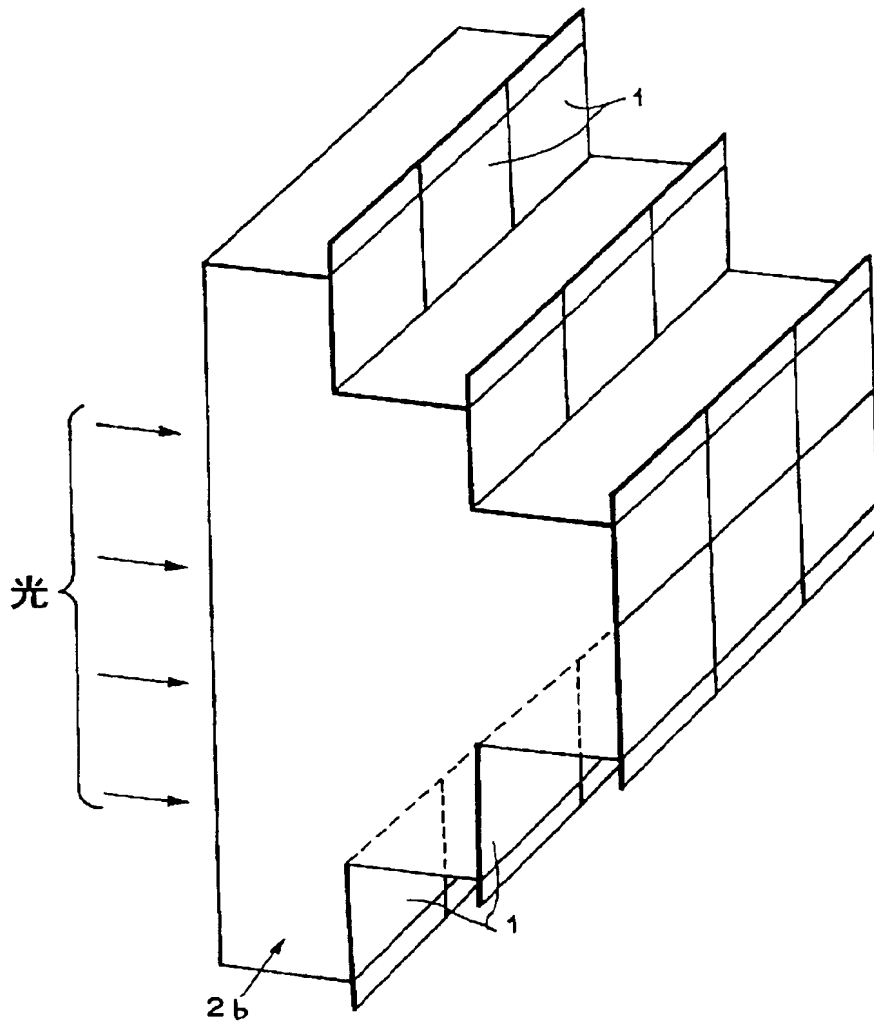
【図 1 1】



【図12】



【图 1 3】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 複数ラインにわたるライン欠陥を防止する。

【解決手段】 放射線を光に変換する蛍光体 3、光を電気信号に変換する光電変換手段と、蛍光体 3 と光電変換手段との間にあって蛍光体 3 からの光を光電変換手段に導く導光手段とを備えた放射線撮像装置において、導光手段はファイバープレート 2 d を接着材 7 を介して繋ぐことで構成されるとともに、光電変換手段は複数の画素が行列状に配されて構成され、ファイバープレート 2 d の繋ぎ方向の接着材の幅は、該繋ぎ方向に配列された画素の幅よりも小さい ( $d < P$ )。

【選択図】 図 3

出願人履歴情報

識別番号 [000001007]

1. 変更年月日 1990年 8月30日  
[変更理由] 新規登録  
住所 東京都大田区下丸子3丁目30番2号  
氏名 キヤノン株式会社